

Fenómenos de transporte en bismuto [Influencia de los Portadores bombeados a una banda metaestable /

González de Sande, Juan Carlos

Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones, [2002]

Monografía

En estos trabajos se ha medido el efecto nernst-ettingshausen en muestras policristalinas de bismuto y a partir de su estudio se han determinado los tiempos de relajación de los distintos portadores, sus masas efectivas y sus potenciales químicos. También se ha estudiado la evolución temporal del efecto termoeléctrico transverso en láminas gruesas de bismuto al ser irradiadas con pulsos láser de dos longitudes de onda distinta: una capaz de bombear portadores a una posible banda metaestable y otra no. Los resultados de este experimento corroboran la existencia de una banda metaestable en bismuto. Se ha desarrollado una técnica para la medida de señales fotoinducidas débiles y de corta duración. Utilizando esta técnica se ha detectado por primera vez un efecto fotoconductivo en bismuto. Además se ha encontrado un efecto de superficie debido al calentamiento no uniforme que produce el pulso láser

Título: Fenómenos de transporte en bismuto Recurso electrónico] Influencia de los Portadores bombeados a una banda metaestable Juan Carlos González de Sande ; director: José Manuel Guerra Pérez

Editorial: Madrid Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones [2002]

Documento fuente: Tesis doctorales publicadas Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Físicas. 1994

Tesis: Tesis de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Físicas, Departamento de Óptica, leída el 16-05-1994

Copyright/Depósito Legal: 914595794

ISBN: 9788466904148 846690414X

Materia: Óptica- Tesis- CD-ROM Óptica- Tesis- CD-ROM. Óptica- Tesis- CD-ROM.

Entidades: Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Físicas. Departamento de Óptica

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Físicas. Departamento de Óptica

Título preferido: Tesis doctorales publicadas Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Físicas. 1994

Enlace a formato físico adicional: Fenómenos de transporte en bismuto: influencia de los portadores bombeados a una banda metaestable

Baratz Innovación Documental

- Gran Vía, 59 28013 Madrid
- (+34) 91 456 03 60
- informa@baratz.es